

	<h2 style="color: red;">SI5435BDC-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI5435BDC-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 4.3A 1206-8
	Datenblätter:  SI5435BDC-T1-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 2709 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	








Spezifikationen

Teilenummer	SI5435BDC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 4.3A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2709 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 4.3A, 10V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5435BDC-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 4.3A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A (Ta)

SI5435BDC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5435BDC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5435BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5435BDC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5435BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 4.3A 1206-8</p>	 <p>SI5435BDC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 4.3A 1206-8</p>	 <p>SI5441BDC VISHAY VISHAY MLP-8</p>	 <p>SI5435DC-T1 VISHAY VISHAY SOT23-8</p>
 <p>SI5433DC-T1-E3 VISHAY SI5433DC-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI5435BDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 4.3A 1206-8</p>	 <p>SI5440DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5433DC-T1-GE3 VISHAY VISHAY 1206-8</p>

SI5435BDC-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5435BDC-T1-GE3 Datenblatt	SI5435BDC-T1-GE3-Datenblätter	SI5435BDC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI5435BDC-T1-GE3 Electronic	SI5435BDC-T1-GE3-Komponenten	SI5435BDC-T1-GE3-Verteiler	SI5435BDC-T1-GE3-Bild	SI5435BDC-T1-GE3-Teil	SI5435BDC-T1-GE3
SI5435BDC-T1-GE3 Preis	SI5435BDC-T1-GE3 Hersteller	SI5435BDC-T1-GE3 Bild	SI5435BDC-T1-GE3 Aktie	SI5435BDC-T1-GE3 Inventar	SI5435BDC-T1-GE3
SI5435BDC-T1-GE3 Neu	SI5435BDC-T1-GE3 Original	SI5435BDC-T1-GE3 garantiert	SI5435BDC-T1-GE3 RFQ	SI5435BDC-T1-GE3 Online bestellen	SI5435BDC-T1-GE3

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited